

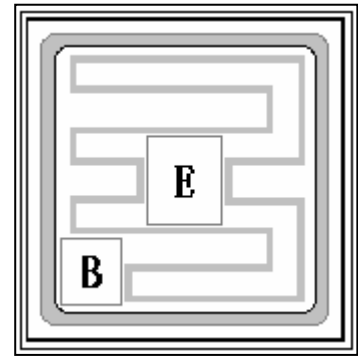


A42 晶体管芯片说明书

芯片简介

芯片尺寸：4 英寸（100mm）
 芯片代码：D072AJ-00
 芯片厚度：240±20μm
 管芯尺寸：720×720μm²
 焊位尺寸：B 极 95×95μm²；E 极 100×100μm²
 电极金属：铝
 背面金属：金
 典型封装：MPSA42，HA42

管芯示意图



极限值 (T_a=25) (封装形式：TO-92)

T_{stg}——贮存温度..... -55~150
 T_j——结温.....150
 P_C——集电极耗散功率.....625mW
 V_{CBO}——集电极—基极电压.....300V
 V_{CEO}——集电极—发射极电压.....300V
 V_{EBO}——发射极—基极电压.....5V
 I_C——集电极电流.....500mA

电参数 (T_a=25) (封装形式：TO-92)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
BV _{CBO}	集电极—基极击穿电压	300			V	I _C =100μA, I _E =0
BV _{CEO}	集电极—发射极击穿电压	300			V	I _C =1mA, I _B =0
BV _{EBO}	发射极—基极击穿电压	6			V	I _E =100μA, I _C =0
I _{CBO}	集电极—基极截止电流			100	nA	V _{CB} =200V, I _E =0
I _{EBO}	发射极—基极截止电流			100	nA	V _{EB} =6V, I _C =0
I _{CES}	集电极—发射极截止电流			1	μA	V _{CE} =300V, V _{BE} =0
h _{FE}	直流电流增益	25				V _{CE} =10V, I _C =1mA
		40		300		V _{CE} =10V, I _C =10mA
		40				V _{CE} =10V, I _C =30mA
V _{CE(sat)}	集电极—发射极饱和电压			0.5	V	I _C =20mA, I _B =2mA
	集电极—发射极饱和电压			1.0	V	I _C =60mA, I _B =6mA
V _{BE(sat)}	基极—发射极饱和电压			0.9	V	I _C =20mA, I _B =2mA
f _T	特征频率	50			MHz	V _{CE} =20V, I _C =10mA, f=100MHz